



中华人民共和国国家标准

GB/T 249—2017
代替 GB/T 249—1989

半导体分立器件型号命名方法

The rule of type designation for discrete semiconductor devices

2017-05-12 发布

2017-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 249—1989《半导体分立器件型号命名方法》，与 GB/T 249—1989 相比主要技术变化如下：

- 混频管和检波管分别命名(见 3.1,1989 年版的 3.1)；
- 二极管第二部分增加了符号 E,代表化合物或合金材料(见 3.1)；
- 增加了噪声管和限幅管的命名(见 3.1)；
- 增加了晶体管阵列的命名(见 3.2)；
- “ZL”由代表整流管阵列改为代表二极管阵列(见 3.2,1989 年版的 3.2)；
- 增加了肖特基二极管的命名(见 3.2)；
- 增加了触发二极管的命名(见 3.2)。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本标准起草单位：中国电子科技集团公司第十三研究所。

本标准主要起草人：陈海蓉、崔波、李丽霞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 249—1964、GB/T 249—1974、GB/T 249—1989。

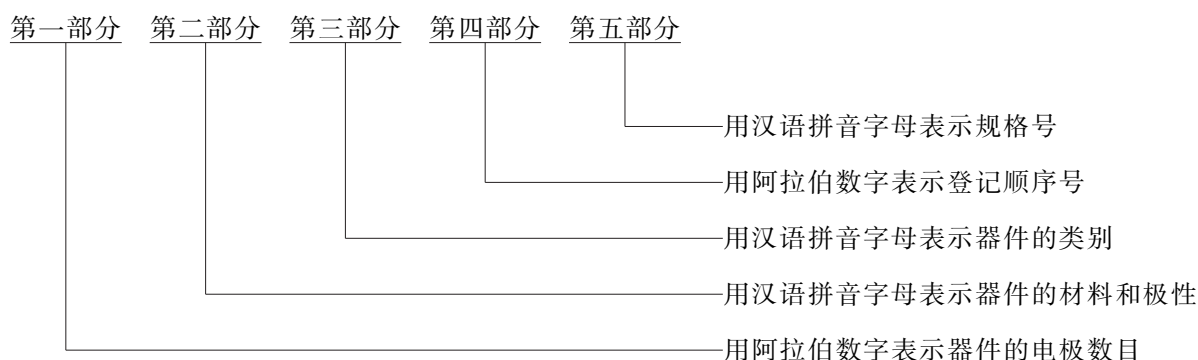
半导体分立器件型号命名方法

1 范围

本标准规定了半导体分立器件型号命名方法的组成原则、组成部分的符号及其意义。
本标准适用于各种半导体分立器件。

2 型号组成原则

2.1 半导体分立器件的型号五个组成部分的基本意义如下：



2.2 半导体分立器件的型号一般由第一部分到第五部分组成，也可以由第三部分到第五部分组成。

3 型号组成部分的符号及其意义

3.1 由第一部分到第五部分组成的器件型号的符号及其意义见表 1。

表 1 由第一部分到第五部分组成的器件型号的符号及其意义

第一部分		第二部分		第三部分		第四部分	第五部分
用阿拉伯数字表示器件的电极数目		用汉语拼音字母表示器件的材料和极性		用汉语拼音字母表示器件的类别		用阿拉伯数字表示登记序号	用汉语拼音字母表示规格号
符号	意义	符号	意义	符号	意义		
2	二极管	A	N 型, 锗材料	P	小信号管		
		B	P 型, 锗材料	H	混频管		
		C	N 型, 硅材料	V	检波管		
		D	P 型, 硅材料	W	电压调整管和电压基准管		
		E	化合物或合金材料	C	变容管		
3	三极管			Z	整流管		
		A	PNP 型, 锗材料	L	整流堆		
		B	NPN 型, 锗材料	S	隧道管		
		C	PNP 型, 硅材料	K	开关管		